10

15

20

25

30

35

## PROCEDE DE SYNTHESE DIRECTE D'ALKYLHALOGENOSILANES

La présente invention se rapporte à des améliorations concernant le procédé industriel mis en œuvre pour la synthèse directe d'alkylhalogénosilanes.

Le procédé industriel de fabrication d'alkylhalogénosilanes et, par exemple, de diméthyldichlorosilane dénommé par la suite DMDCS est un procédé bien connu qui est décrit notamment dans le brevet des Etats-Unis d'Amérique US-A-2 380 995, ainsi que dans l'ouvrage de Walter NOLL, Chemistry and Technology of Silicones, 1968, édition Académie Press Inc., LONDON, pages 26-41.

Selon ce procédé dit de "synthèse directe" ou "synthèse de Rochow", on fabrique directement les alkylhalogénosilanes, par exemple le DMDCS, par réaction du chlorure de méthyle sur une masse solide, dite masse de contact, formée de silicium et d'un catalyseur comprenant du cuivre, suivant la réaction :

$$2CH_3CI + Si -> (CH_3)_2SiCl_2$$
.

En réalité il se forme au cours de la synthèse directe d'autres co-produits tels que ceux mentionnés ci-après : d'autres alkylhalogénosilanes comme le méthyltrichlorosilane CH<sub>3</sub>SiCl<sub>3</sub> dénommé par la suite MTCS et le triméthylchlorosilane (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>SiCl dénommé par la suite TMCS ; des alkylhydrogénosilanes halogénés comme par exemple le méthylhydrogénodichlorosilane (CH<sub>3</sub>)HSiCl<sub>2</sub> dénommé par la suite MHDCS ; et des produits lourds qui sont des polysilanes, et en particulier des disilanes comme par exemple le triméthyltrichlorodisilane (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>Si<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub> et le diméthyltétrachlorodisilane (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub>.

A propos de la composition de la masse de contact, il est connu d'utiliser le cuivre, pris sous forme de cuivre métallique ou sous forme de composés chimiques à base de cuivre, comme catalyseur de la réaction de synthèse directe. Il est également connu, dans le but d'amener les performances de la synthèse directe à un niveau économiquement viable, de rajouter dans la masse de contact un ou plusieurs additif(s) promoteur(s). Ces additifs promoteurs peuvent être : le zinc ou un halogénure de zinc (brevet US-A-2 464 033) ; l'aluminium (brevets US-A-2 403 370 et 2 427 605) ; l'étain, le manganèse, le nickel et l'argent (brevet britannique GB-A-1 207 466) ; le cobalt (brevet britannique GB-A-907 161) ; le chlorure de potassium (brevet soviétique SU-A-307 650) ; l'arsenic ou un composé de l'arsenic (brevet US-A-4 762 940) ; le césium ou un composé du césium (EP-A-1 138 678) ; un additif choisi parmi l'élément phosphore, un phosphure métallique et un composé apte à fournir un phosphure métallique dans la masse réactionnelle de la synthèse directe (brevet US-A-4 601 101) ; des mélanges particuliers de certaines des espèces précitées (FR-A-2 848 124 et FR-A-2 848 211).

Il a maintenant été trouvé, et c'est ce qui constitue l'objet de la présente invention,

que:

5

10

15

20

30

35

combinaison:

- dans le cas de la mise en œuvre d'une synthèse directe où la masse de contact est formée de silicium et d'un système catalytique comportant un catalyseur au cuivre et un groupe d'additifs promoteurs à base de zinc et d'étain.
- si d'une part le catalyseur au cuivre est engagé sous la forme de cuivre métallique et/ou d'un halogénure de cuivre, et d'autre part la masse de contact renferme en outre un additif promoteur complémentaire judicieusement choisi parmi les dérivés des acides du phosphore,
- on observe alors : d'une part une amélioration sensible de la sélectivité en dialkyldihalogénosilane, et par exemple en DMDCS, évaluée par le rapport moyen MTCS/DMDCS, et d'autre part un abaissement sensible de la teneur pondérale en produits "lourds" par rapport aux silanes obtenus, tout en maintenant une activité moyenne très satisfaisante de la masse de contact, ladite activité étant évaluée en poids des silanes obtenus par heure et par kilogramme de silicium engagé.

D'autres avantages liés à la mise en œuvre de la présente invention apparaîtront dans la suite du présent mémoire.

La présente invention propose en conséquence un procédé de préparation d'alkylhalogénosilanes par réaction d'un halogénure d'alkyle, de préférence CH<sub>3</sub>Cl, avec une masse solide, dite masse de contact, formée de silicium et d'un système catalytique comportant (α) un catalyseur au cuivre, et (β) un groupe d'additifs promoteurs comprenant : - un additif β1 choisi parmi le zinc métallique, un composé à base de zinc et un mélange de ces espèces.

- un additif β2 choisi parmi l'étain, un composé à base d'étain et un mélange de ces espèces,
- éventuellement un additif β3 choisi parmi le césium, le potassium, le rubidium, un composé dérivé de ces métaux et un mélange de ces espèces, ledit procédé de synthèse directe étant caractérisé par les points suivants pris en
  - le catalyseur au cuivre (α) est sous la forme de cuivre métallique, d'un halogénure de cuivre ou d'un mélange de ces espèces,
  - la masse de contact renferme en outre un additif promoteur complémentaire β4 choisi parmi un dérivé d'un acide du phosphore et un mélange de ces espèces.

A noter que par l'expression "un dérivé d'un acide du phosphore", on entend désigner un composé du phosphore qui est absolument différent d'un phosphure métallique (et ne doit pas être confondu avec un phosphure métallique) qui est connu pour englober les combinaisons et alliages de phosphore avec au moins un autre

10

15

20

25

30

35

élément métallique pris à l'état simple.

A la place du cuivre métallique, on peut utiliser à titre d'halogénure de cuivre : un halogénure cuivreux, comme par exemple le chlorure cuivreux ; un halogénure cuivrique, comme par exemple le chlorure cuivrique ; et un mélange de ces espèces. On utilise de préférence le cuivre métallique et/ou le chlorure cuivreux.

On peut utiliser à titre d'additif complémentaire  $\beta 4$ : un sel alcalin, un sel alcalinoterreux ou un sel métallique d'un acide hypophosphoreux ; un sel alcalin, un sel alcalinoterreux ou un sel métallique d'un acide phosphoreux (ortho, pyro, méta) ; un sel alcalin, un sel alcalino-terreux ou un sel métallique d'un acide hypophosphorique ; un sel alcalin, un sel alcalino-terreux ou un sel métallique d'un acide phosphorique (ortho, pyro, méta) ; un sel alcalin d'un acide polyphosphorique de formule  $M_{n+2}(P_nO_{3n+1})$  où M représente un métal alcalin et n est un nombre allant de 1 à 10 ; et un mélange de ces sels.

On utilise de préférence : un sel alcalin, un sel alcalino-terreux et/ou un sel de cuivre d'un acide hypophosphoreux, comme par exemple l'hypophosphite de sodium  $NaH_2PO_2$ , l'hypophosphite de potassium  $KH_2PO_2$ , l'hypophosphite de calcium  $Ca(H_2PO_2)_2$ , l'hypophosphite de magnésium  $Mg(H_2PO_2)_2$ , l'hypophosphite d'aluminium  $Al(H_2PO_2)_3$  et/ou l'hypophosphite de cuivre-II  $Cu(H_2PO_2)_2$ ; un sel alcalin, un sel alcalino-terreux et/ou un sel de cuivre d'un acide phosphorique (ortho, pyro, méta), comme par exemple le phosphate trisodique  $Na_3PO_4$ , le phosphate tripotassique  $K_3PO_4$ , le phosphate monocalcique  $Ca(H_2PO_4)_2$ , le phosphate bicalcique  $CaHPO_4$ , le phosphate tricalcique  $Ca_3(PO_4)_2$ , l'hydroxyorthophosphate de calcium  $Ca_3(PO_4)_3OH$  et/ou le phosphate de cuivre-II  $Cu(H_2PO_4)_2$ ; un sel alcalin d'un acide polyphosphorique ayant la formule précitée où n=3, comme par exemple le polyphosphate de sodium  $Na_5P_3O_{10}$ .

La quantité d'additif β4 (calculée en poids de phosphore élémentaire par rapport à la masse de silicium engagé) se situe dans l'intervalle allant de 50 à 3000 ppm et, de préférence, allant de 80 à 1500 ppm et, mieux encore, allant de 90 à 1200 ppm; au dessous de 50 ppm l'action du phosphore n'est pas vraiment décelable et au-dessus de 3000 ppm, le phosphore a un effet poison qui abaisse la productivité.

Selon une première variante de mise en œuvre de l'invention, l'additif promoteur complémentaire  $\beta 4$  est ajouté dans la masse de contact (à coté du silicium, du catalyseur au cuivre et des additifs promoteurs  $\beta 1$ ,  $\beta 2$  et éventuellement  $\beta 3$ ) dans l'état où il se trouve naturellement. Dans le cas de cette première variante, on utilise plus préférentiellement l'hypophosphite de sodium NaH<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>, l'hypophosphite de potassium KH<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>, l'hypophosphite de calcium Ca(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, l'hypophosphite de magnésium Mg(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, l'hypophosphite d'aluminium Al(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>3</sub> et/ou l'hypophosphite de cuivre-II Cu(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>. Convient tout spécialement bien l'hypophosphite de calcium Ca(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.

Dans le cas de la première variante, convient tout spécialement bien l'emploi de 80

10

15

20

25

30

35

à 1500 ppm dudit hypophosphite de calcium Ca(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.

Selon une seconde variante de mise en œuvre de l'invention, l'additif promoteur complémentaire  $\beta 4$  est ajouté dans la masse de contact (à coté du silicium et des additifs promoteurs  $\beta 1$ ,  $\beta 2$  et éventuellement  $\beta 3$ ) sous la forme d'un adduct comportant l'halogénure de cuivre constituant le catalyseur ( $\alpha$ ) et au moins un dérivé d'un acide du phosphore.

L'adduct utilisé dans le procédé conforme à l'invention est une matière sous forme particulaire qui est généralement mise en œuvre à l'état préformé. Pour la préparation (réalisée au préalable) de l'adduct, on peut faire appel à n'importe quel procédé commode pour mélanger mécaniquement et rendre ensuite homogène le mélange ainsi obtenu, l'halogénure de cuivre avec l'additif à base d'au moins un dérivé d'un acide du phosphore. On peut par exemple broyer l' halogénure de cuivre et l'additif, l'un et l'autre sous forme de particules comme par exemple une poudre, en opérant dans n'importe quel appareil de mélange conçu à cet effet.

Dans cette seconde variante, on utilise plus préférentiellement le phosphate trisodique  $Na_3PO_4$ , le phosphate tripotassique  $K_3PO_4$ , le phosphate monocalcique  $Ca(PO_4H_2)_2$ , le phosphate bicalcique  $CaHPO_4$ , le phosphate tricalcique  $Ca_3(PO_4)_2$ , l'hydroxyorthophosphate de calcium  $Ca_3(PO_4)_3OH$ , le phosphate de cuivre-II  $Cu(H_2PO_4)_2$ , et/ou le polyphosphate de sodium  $Na_5P_3O_{10}$ . Conviennent tout spécialement bien, le phosphate tricalcique  $Ca_3(PO_4)_2$ , et/ou l'hydroxyorthophosphate de calcium  $Ca_3(PO_4)_3OH$ .

On a également trouvé que le fait d'utiliser le catalyseur au cuivre sous cette forme d'adduct a pour conséquence celle de procurer audit catalyseur une coulabilité (ce qui en facilite bien entendu la mise en œuvre) qui peut être améliorée par rapport à celles possédées par l'halogénure de cuivre utilisé seul (c'est à dire non sous forme d'adduct).

La quantité d'additif β4 dans l'adduct n'est pas d'une importance capitale et elle peut varier entre de larges limites. Suivant l'invention, on préfère utiliser un adduct sous forme particulaire dans lequel se trouve de 0,5 à 10% et, mieux, de 1 à 5% de son poids d'additif consistant dans au moins un dérivé d'un acide du phosphore.

Dans le cadre de la seconde variante, convient tout spécialement bien l'emploi d'un adduct sous forme particulaire dans lequel l'halogénure de cuivre est le chlorure cuivreux et où il se trouve de 1 à 5% de son poids de phosphate tricalcique Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> et/ou d'hydroxyorthophosphate de calcium Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>OH.

Le catalyseur (α) est utilisé généralement, dans le cas de la première variante comme dans celui de la seconde, à une teneur pondérale allant de 1 à 20%, de préférence allant de 2 à 12%, par rapport à la masse de silicium engagé. Dans le cas de la seconde variante, la quantité de catalyseur (α) est choisie - à l'intérieur des zones de variation générale et préférée précitées et en fonction de la composition de l'adduct - de manière à

10

15

20

25

30

apporter dans la masse de contact une teneur en dérivé(s) d'un acide du phosphore (calculée en ppm de phosphore élémentaire par rapport à la masse de silicium engagé) qui se situe dans l'intervalle allant de 50 à 3000 ppm et, de préférence, allant de 80 à 1500 ppm et, mieux encore, allant de 90 à 1200 ppm.

5

PCT/FR2004/002759

Dans le cadre de cette seconde variante, convient donc tout spécialement bien l'emploi d'une quantité d'adduct à base de chlorure cuivreux et de 1 à 5% de son poids de phosphate tricalcique  $Ca_3(PO_4)_2$  et/ou d'hydroxyorthophosphate de calcium  $Ca_3(PO_4)_3OH$  qui apporte 80 à 1500 ppm de phosphore élémentaire.

Selon le mode de réalisation défini supra, le système catalytique contient en outre un additif promoteur  $\beta$ 1 à base de zinc métallique et/ou d'un composé du zinc ; on utilise de préférence le zinc métallique et/ou le chlorure de zinc.

L'additif promoteur β1 est présent à une teneur pondérale située dans l'intervalle allant de 0,01 à 2 %, de préférence allant de 0,02 à 0,5 %, (calculée en zinc métal par rapport au poids de silicium engagé). Jusqu'à 90 % en poids du zinc, de préférence jusqu'à 50 % en poids du zinc peut être remplacé par un autre métal qui catalyse la chloration du cuivre et/ou qui forme un eutectique ou une phase à bas point de fusion avec les sels de cuivre et/ou les sels alcalins. Comme métal pouvant convenir on peut citer le cadmium, l'aluminium, le manganèse et l'argent.

La teneur pondérale en étain et/ou en composé de l'étain (additif promoteur β2 dont la teneur est calculée en poids d'étain métal) se situe dans l'intervalle allant de 10 à 500 ppm et, de préférence, allant de 30 à 300 ppm par rapport à la masse de silicium engagée.

Il est nécessaire d'avoir au moins 10 ppm d'étain métal. En outre une teneur pondérale supérieure à 500 ppm aurait un effet néfaste sur la réaction et notamment sur la sélectivité. Comme composé à base d'étain, on utilise par exemple le chlorure d'étain. L'additif promoteur β2 qui est utilisé de préférence est l'étain métal; avantageusement cet étain métallique peut être ajouté sous forme de bronze.

A propos de l'additif promoteur facultatif  $\beta 3$ , dans le cas où on en utilise un, on précisera les points qui suivent :

- la teneur pondérale en additif promoteur β3 de type métal (calculée en poids de métal alcalin par rapport à la masse de silicium engagée) se situe dans l'intervalle allant de 0,01 à 2 % en poids et, de préférence, allant de 0,05 à 1,0 % en poids ; au dessous de 0,01 % en poids l'action du métal alcalin n'est pas vraiment décelable et audessus de 2 % en poids, le métal alcalin n'a pas l'effet attendu sur la sélectivité ;
- comme composé de métal alcalin choisi parmi le Cs, le K et le Rb, on peut utiliser : les halogénures et par exemple le chlorure ; les carboxylates et par exemple le formiate ou l'acétate ; le chlorure de césium, le chlorure de potassium, le chlorure de

10

15

20

25

30

35

rubidium et/ou un mélanges de ces composés sont les additifs promoteurs β3 de type métal qui sont utilisés de préférence.

Pour le reste, il est souhaitable que la dimension particulaire du silicium soit telle que le diamètre moyen d'au moins 50 % en poids des particules soit compris entre 10 et 500  $\mu$ m et, de préférence, entre 60 et 200  $\mu$ m. De même le catalyseur ( $\alpha$ ) et le groupe de promoteurs ( $\beta$ ) se trouvent également sous forme de particules dont le diamètre moyen d'au moins 50 % en poids des particules est avantageusement compris entre 1 et 100  $\mu$ m.

Le procédé de synthèse directe selon l'invention peut être mis en œuvre de façon générale dans un des trois types d'appareillages suivants : un réacteur du type à lit agité comme celui décrit dans le brevet des Etats-Unis d'Amérique US-A-2 449 821, un réacteur du type à lit fluidisé comme celui décrit dans le brevet des Etats-Unis d'Amérique US-A-2 389 931 ou dans un four rotatif.

La réaction de synthèse directe a lieu à une température se situant dans l'intervalle allant de 260 à 400°C et, de préférence, allant de 280 à 380 °C. Elle peut être conduite, en tout ou partie, sous une pression absolue d'halogénure d'alkyle égale à la pression atmosphérique (1 bar) ou supérieure à la pression atmosphérique; quand on se situe dans ce dernier cas, on travaille généralement sous une pression absolue allant de 1,1 à 8 bars et ,de préférence, allant de 1,5 à 5 bars.

Pour la conduite de la réaction de synthèse directe, on réalise avantageusement au préalable, comme cela est bien connu, une étape initiale d'activation de la masse de contact (formée par l'ensemble à base de silicium + catalyseur + promoteurs); un des moyens d'activation qui convient bien peut consister à porter ladite masse de contact à une certaine température qui peut être inférieure ou supérieure de quelques degrés à quelques dizaines de degrés à la température choisie pour la réaction de synthèse directe et située dans l'intervalle général ou préférentiel mentionné supra.

En utilisant le système catalytique ( $\alpha$ ) + ( $\beta$ ) selon l'invention, on peut obtenir, lorsque la réaction est mise en œuvre, en lit agité comme en lit fluidisé, à une température allant de 260°C à 400°C et, de préférence, allant de 280 à 380 °C, une sélectivité en dialkyldihalogénosilane élevées et une teneur pondérale en sous-produits lourds faible, tout en ayant une activité moyenne très satisfaisante.

S'agissant de la sélectivité, évaluée par exemple par le rapport pondéral moyen MTCS/DMDCS: la valeur obtenue est de l'ordre ou inférieur à 0,10, pouvant atteindre une valeur aussi faible que 0,050.

S'agissant du pourcentage de lourds formés par rapport aux silanes obtenus, il est généralement inférieur à 3 % en poids, et il peut être aussi faible que 2 % en poids.

S'agissant de l'activité moyenne du système catalytique, elle est par exemple de l'ordre ou supérieure à 120 g de silanes/h/kg Si, pouvant atteindre 200 g de silanes/h/kg Si et même plus.

D'autres avantages et caractéristiques de la présente invention apparaîtront à la lecture des exemples suivants donnés à titre illustratif mais nullement limitatif.

Dans les exemples suivants, sauf mention contraire, on utilise un réacteur pilote cylindrique de diamètre intérieur 60 mm et de hauteur 250 mm, muni à sa base d'un distributeur de gaz en verre fritté. Le silicium et le système catalytique sont chargés sous forme d'une poudre dont la taille moyenne d'au moins 50 % en poids des particules est comprise entre 60 et 200 µm.

La réaction s'effectue en lit agité et le réacteur est muni d'un élément chauffant extérieur.

# **ESSAI COMPARATIF A:**

5

10

20

25

30

35

15 Système catalytique : CuCl / ZnCl<sub>2</sub> / Sn

Dans un réacteur vertical, cylindrique, en verre, muni d'un agitateur métallique et d'un distributeur de gaz en verre fritté, on charge une poudre constituée de : 210 g de silicium, 11,5 g de CuCl, 1,44 g de ZnCl<sub>2</sub> et 0,38 g de bronze contenant 10 % en poids d'étain.

On chauffe progressivement le réacteur jusqu'à 200°C sous un courant d'azote. Puis en continuant d'élever la température du réacteur, on ferme le robinet d'azote et on commence à introduire le chlorure de méthyle avec un débit, mesuré à 20°C, de 60 g/h.

La température du réacteur est régulée à 315°C et le débit de chlorure de méthyle est maintenu à 60 g/h pendant 8 heures, l'essai se déroule à pression atmosphérique.

Le mélange produit est analysé par chromatographie en phase vapeur, et il est caractérisé par :

- un ratio MTCS/DMDCS égal à 0,129 (% pondéral/ % pondéral), et
- une proportion de "lourds" (polysilanes) s'élevant à 5,2 % en poids.

**EXEMPLE 1** 

Système catalytique : CuCl / ZnCl<sub>2</sub> / Sn / Ca (H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>

Dans un réacteur vertical, cylindrique, en verre, muni d'un agitateur métallique et d'un distributeur de gaz en verre fritté, on charge une poudre constituée de : 210 g de silicium, 11,5 g de CuCl, 1,44 g de ZnCl<sub>2</sub>, 0,38 g de bronze contenant 10 % en poids d'étain et 0,576 g de Ca (H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> (1000 ppm de P par rapport au Si engagé).

10

15

20

25

35

On chauffe progressivement le réacteur jusqu'à 200°C sous un courant d'azote. Puis en continuant d'élever la température du réacteur, on ferme le robinet d'azote et on commence à introduire le chlorure de méthyle avec un débit, mesuré à 20°C, de 60 g/h.

La température du réacteur est régulée à 315°C et le débit de chlorure de méthyle est maintenu à 60 g/h pendant 8 heures, l'essai se déroule à pression atmosphérique.

Le mélange produit est analysé par chromatographie en phase vapeur, et il est caractérisé par :

- un ratio MTCS/DMDCS égal à 0,069 (% pondéral/ % pondéral), et
- une proportion de "lourds" (polysilanes) s'élevant à 1,5 % en poids.

# ESSAI COMPARATIF B:

Système catalytique : CuCl / ZnCl<sub>2</sub> / Sn / Cu<sub>3</sub>P

Dans un réacteur vertical, cylindrique, en verre, muni d'un agitateur métallique et d'un distributeur de gaz en verre fritté, on charge une poudre constituée de : 210 g de silicium, 11,5 g de CuCl, 1,44 g de ZnCl<sub>2</sub>, 0,38 g de bronze contenant 10 % en poids d'étain et 2,92 g de phosphure de cuivre Cu<sub>3</sub>P contenant 7,2 % de phosphore (1000 ppm de P par rapport au Si engagé).

On chauffe progressivement le réacteur jusqu'à 200°C sous un courant d'azote. Puis en continuant d'élever la température du réacteur, on ferme le robinet d'azote et on commence à introduire le chlorure de méthyle avec un débit, mesuré à 20°C, de 60 g/h.

La température du réacteur est régulée à 315°C et le débit de chlorure de méthyle est maintenu à 60 g/h pendant 8 heures, l'essai se déroule à pression atmosphérique.

Le mélange produit est analysé par chromatographie en phase vapeur, et il est caractérisé par :

- un ratio MTCS/DMDCS égal à 0,123 (% pondéral/ % pondéral), et
- une proportion de "lourds" (polysilanes) s'élevant à 3,6 % en poids.

# · ESSAI COMPARATIF C:

30 Système catalytique : CuCl / ZnCl<sub>2</sub> / Sn

Dans un réacteur vertical, cylindrique, en verre, muni d'un agitateur métallique et d'un distributeur de gaz en verre fritté, on charge une poudre constituée de : 210 g de silicium, 16,4 g de CuCl, 1,64 g de ZnCl<sub>2</sub> et 0,38 g de bronze contenant 10 % en poids d'étain.

On chauffe progressivement le réacteur jusqu'à 200°C sous un courant d'azote. Puis en continuant d'élever la température du réacteur, on ferme le robinet d'azote et on

commence à introduire le chlorure de méthyle avec un débit, mesuré à 20°C, de 60 g/h.

La température du réacteur est régulée à 315°C et le débit de chlorure de méthyle est maintenu à 60 g/h pendant 8 heures, l'essai se déroule à pression atmosphérique.

Le mélange produit est analysé par chromatographie en phase vapeur, et il est caractérisé par :

- un ratio MTCS/DMDCS égal à 0,112 (% pondéral/ % pondéral), et
- une proportion de "lourds" (polysilanes) s'élevant à 4,0 % en poids.

# **EXEMPLE 2**

5

15

20

25

30

35

10 Système catalytique : CuCl,Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> / ZnCl<sub>2</sub> / Sn

Dans un réacteur vertical, cylindrique, en verre, muni d'un agitateur métallique et d'un distributeur de gaz en verre fritté, on charge une poudre constituée de : 210 g de silicium, 16,4 g d'adduct CuCl,Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> contenant 2 % en poids de Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, 1,64 g de ZnCl<sub>2</sub> et 0,38 g de bronze contenant 10 % en poids d'étain.

L'adduct est préparé par mélange mécanique, en opérant dans un mélangeur TURBULA (d'origine PROLABO), de la poudre de CuCl (d'origine PROLABO) avec de la poudre de Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> (d'origine PROLABO).

On chauffe progressivement le réacteur jusqu'à 200°C sous un courant d'azote. Puis en continuant d'élever la température du réacteur, on ferme le robinet d'azote et on commence à introduire le chlorure de méthyle avec un débit, mesuré à 20°C, de 60 g/h.

La température du réacteur est régulée à 315°C et le débit de chlorure de méthyle est maintenu à 60 g/h.

L'essai se déroule à pression atmosphérique. L'essai est arrêté par l'opérateur après 8 heures de production de méthylchlorosilanes (MCS).

Le mélange produit est analysé par chromatographie en phase vapeur, et il est caractérisé par :

- un ratio MTCS/DMDCS égal à 0,089 (% pondéral/ % pondéral), et
- une proportion de "lourds" (polysilanes) s'élèvant à 2,8 % en poids.

## **ESSAI COMPARATIF D:**

Système catalytique : Cu° / ZnCl<sub>2</sub> / Sn

Dans un réacteur vertical, cylindrique, en verre, muni d'un agitateur métallique et d'un distributeur de gaz en verre fritté, on charge une poudre constituée de : 210 g de silicium, 21,0 g de cuivre métallique, 1,64 g de ZnCl<sub>2</sub> et 0,38 g de bronze contenant 10 % en poids d'étain.

WO 2005/044827 PCT/FR2004/002759

10

On chauffe progressivement le réacteur jusqu'à 200°C sous un courant d'azote. Puis en continuant d'élever la température du réacteur, on ferme le robinet d'azote et on commence à introduire le chlorure de méthyle avec un débit, mesuré à 20°C, de 60 g/h.

La température du réacteur est régulée à 315°C et le débit de chlorure de méthyle est maintenu à 60 g/h pendant 8 heures, l'essai se déroule à pression atmosphérique.

Le mélange produit est analysé par chromatographie en phase vapeur, et il est caractérisé par :

- un ratio MTCS/DMDCS égal à 0,168 (% pondéral/ % pondéral), et
- une proportion de "lourds" (polysilanes) s'élevant à 8 % en poids.

10

15

20

5

## **EXEMPLE 3**

Système catalytique : Cu° / ZnCl<sub>2</sub> / Sn / Ca (H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>

Dans un réacteur vertical, cylindrique, en verre, muni d'un agitateur métallique et d'un distributeur de gaz en verre fritté, on charge une poudre constituée de : 210 g de silicium, 21,0 g de cuivre métallique, 1,64 g de ZnCl<sub>2</sub>, 0,38 g de bronze contenant 10 % en poids d'étain et 0,576 g de Ca (H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> (1000 ppm de P par rapport au Si engagé).

On chauffe progressivement le réacteur jusqu'à 200°C sous un courant d'azote. Puis en continuant d'élever la température du réacteur, on ferme le robinet d'azote et on commence à introduire le chlorure de méthyle avec un débit, mesuré à 20°C, de 60 g/h.

La température du réacteur est régulée à 315°C et le débit de chlorure de méthyle est maintenu à 60 g/h pendant 8 heures, l'essai se déroule à pression atmosphérique.

Le mélange produit est analysé par chromatographie en phase vapeur, et il est caractérisé par :

- un ratio MTCS/DMDCS égal à 0,091 (% pondéral/ % pondéral), et
- une proportion de "lourds" (polysilanes) s'élevant à 1,7 % en poids.

## **ESSAI COMPARATIF E:**

Système catalytique : Cu° / ZnCl<sub>2</sub> / Sn / Cu<sub>3</sub>P

30

35

25

Dans un réacteur vertical, cylindrique, en verre, muni d'un agitateur métallique et d'un distributeur de gaz en verre fritté, on charge une poudre constituée de : 210 g de silicium, 21,0 g de cuivre métallique, 1,64 g de ZnCl<sub>2</sub>, 0,38 g de bronze contenant 10 % en poids d'étain et 2,95 g de phosphure de cuivre Cu<sub>3</sub>P contenant 7,2 % de phosphore (1000 ppm de P par rapport au Si engagé).

On chauffe progressivement le réacteur jusqu'à 200°C sous un courant d'azote. Puis en continuant d'élever la température du réacteur, on ferme le robinet d'azote et on

commence à introduire le chlorure de méthyle avec un débit, mesuré à 20°C, de 60 g/h.

La température du réacteur est régulée à 315°C et le débit de chlorure de méthyle est maintenu à 60 g/h pendant 8 heures, l'essai se déroule à pression atmosphérique.

Le mélange produit est analysé par chromatographie en phase vapeur, et il est caractérisé par :

- un ratio MTCS/DMDCS égal à 0,116 (% pondéral/ % pondéral), et

5

- une proportion de "lourds" (polysilanes) s'élevant à 4,3 % en poids.

15

20

25

30

35

### **REVENDICATIONS**

- 1) Procédé de préparation d'alkylhalogénosilanes par réaction d'un halogénure d'alkyle, de préférence CH<sub>3</sub>Cl, avec une masse solide, dite masse de contact, formée de silicium et d'un système catalytique comportant (α) un catalyseur au cuivre, et (β) un groupe d'additifs promoteurs comprenant :
- un additif β1 choisi parmi le zinc métallique, un composé à base de zinc et un mélange de ces espèces,
- un additif β2 choisi parmi l'étain, un composé à base d'étain et un mélange de ces 10 espèces,
  - éventuellement un additif β3 choisi parmi le césium, le potassium, le rubidium, un composé dérivé de ces métaux et un mélange de ces espèces,

ledit procédé de synthèse directe étant caractérisé par les points suivants pris en combinaison :

- le catalyseur au cuivre (α) est sous la forme de cuivre métallique, d'un halogénure de cuivre ou d'un mélange de ces espèces,
- la masse de contact renferme en outre un additif promoteur complémentaire β4 choisi parmi un dérivé d'un acide du phosphore et un mélange de ces espèces.
- 2) Procédé selon la revendication 1, caractérisé le catalyseur (α) est utilisé à une teneur pondérale allant de 1 à 20% par rapport à la masse de silicium engagé.
- 3) Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l'additif promoteur complémentaire  $\beta 4$  est choisi parmi : un sel alcalin, un sel alcalino-terreux ou un sel métallique d'un acide hypophosphoreux ; un sel alcalin, un sel alcalino-terreux ou un sel métallique d'un acide phosphoreux (ortho, pyro, méta) ; un sel alcalin, un sel alcalino-terreux ou un sel métallique d'un acide hypophosphorique ; un sel alcalin, un sel alcalino-terreux ou un sel métallique d'un acide phosphorique (ortho, pyro, méta) ; un sel alcalin d'un acide polyphosphorique de formule  $M_{n+2}(P_nO_{3n+1})$  où M représente un métal alcalin et n est un nombre allant de 1 à 10 ; et un mélange de ces sels.
- 4) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la teneur en additif β4 est située dans l'intervalle allant de 50 à 3000 ppm.
- 5) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que, selon une première variante de mise en œuvre de l'invention, l'additif promoteur

complémentaire  $\beta 4$  est ajouté dans la masse de contact - à coté du silicium, du catalyseur au cuivre et des additifs promoteurs  $\beta 1$ ,  $\beta 2$  et éventuellement  $\beta 3$  - dans l'état où il se trouve naturellement.

6) Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que l'on utilise l'hypophosphite de sodium NaH<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>, l'hypophosphite de potassium KH<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>, l'hypophosphite de calcium Ca(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, l'hypophosphite de magnésium Mg(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, l'hypophosphite de cuivre-II Cu(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> et/ou l'hypophosphite d'aluminium Al(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>3</sub>.

5

15

20

25

30

35

- 7) Procédé selon la revendication 5 ou 6, caractérisé en ce que l'on utilise l'hypophosphite Ca(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.
  - 8) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que, selon une seconde variante de mise en œuvre de l'invention, l'additif promoteur complémentaire  $\beta$ 4 est ajouté dans la masse de contact à coté du silicium et des additifs promoteurs  $\beta$ 1,  $\beta$ 2 et éventuellement  $\beta$ 3 sous la forme d'un adduct comportant l'halogénure de cuivre constituant le catalyseur ( $\alpha$ ) et au moins un dérivé d'un acide du phosphore.
  - 9) Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que l'on utilise le phosphate trisodique  $Na_3PO_4$ , le phosphate tripotassique  $K_3PO_4$ , le phosphate monocalcique  $Ca(PO_4H_2)_2$ , le phosphate bicalcique  $CaHPO_4$ , le phosphate tricalcique  $Ca_3(PO_4)_2$ , l'hydroxyorthophosphate de calcium  $Ca_3(PO_4)_3OH$ , le phosphate de cuivre-II  $Cu(H_2PO_4)_2$  et/ou le polyphosphate de sodium  $Na_5P_3O_{10}$ .
    - 10) Procédé selon la revendication 8 ou 9, caractéris é en ce que l'on utilise le phosphate tricalcique Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> et/ou l'hydroxyorthophosphate de calcium Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>OH.
  - 11) Procédé selon l'une quelconque des revendications 8 à 10, caractérisé en ce que la quantité de catalyseur (a) est choisie à l'intérieur de la zone de variation générale selon la revendication 2 et en fonction de la composition de l'adduct de manière à apporter dans la masse de contact une teneur en dérivé(s) d'un acide du phosphore, calculée en ppm de phosphore élémentaire par rapport à la masse de silicium engagé, qui se situe dans l'intervalle allant de 50 à 3000 ppm
    - 12) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que la teneur en additif β1 est située dans l'intervalle allant de 0,01 à 2,0 %.

WO 2005/044827 PCT/FR2004/002759

14

- 13) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que l'additif β1 est le zinc métallique et/ou le chlorure de zinc.
- 14) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisé en ce
   que la teneur en additif β2 est située dans l'intervalle allant de 10 à 500 ppm.
  - 15) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que l'additif β2 est l'étain métal.
- 10 16) Procédé selon la revendication 15, caractérisé en ce que l'étain métallique est engagé sous forme de bronze.
  - 17) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 16, caractérisé en ce que la teneur en additif  $\beta$ 3, quand on en utilise un, est située dans l'intervalle allant de : 0,01 à 2,0 %.
  - 18) Procédé selon la revendication 17, caractérisé en ce que l'additif β3 est le chlorure de césium, le chlorure de potassium, le chlorure de rubidium et/ou un mélange de ces composés.

20

25

15

19) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 18, caractérisé en ce que la réaction de synthèse directe est conduite à une température se situant dans l'intervalle allant de 260°C à 400°C, sous une pression égale ou supérieure à la pression atmosphérique.

# BEST AVAILABLE COPY

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internal al Application No
PCT/FR2004/002759

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C07F7/16

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

### **B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  $IPC \ 7 \ C07F$ 

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, BEILSTEIN Data

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,A	FR 2 848 211 A (RHONE POULENC CHIMIE) 11 June 2004 (2004-06-11) claim 1	1-19
A	EP 0 778 279 A (DOW CORNING) 11 June 1997 (1997-06-11) claim 1; table 1	1-19
A	US 6 258 970 B1 (BABLIN JOHN MATTHEW ET AL) 10 July 2001 (2001-07-10) claim 1; figure 1	1-19
A	EP 1 156 051 A (GEN ELECTRIC) 21 November 2001 (2001-11-21) claim 1	1-19

Further documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in annex
Special categories of cited documents:      A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance      E* earlier document but published on or after the international filing date      L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)      O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means      P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	<ul> <li>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</li> <li>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</li> <li>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art</li> <li>"&amp;" document member of the same patent family</li> </ul>
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
20 April 2005	02/05/2005
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer
European Patent Office, P B 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo nl, Fax (+31-70) 340-3016	Baston, E

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internal Application No
PCT/FR2004/002759

ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
EP 1 173 447 A (GEN ELECTRIC) 23 January 2002 (2002-01-23) claim 1	1-19
DE 34 25 424 A (GEN ELECTRIC) 7 February 1985 (1985-02-07) claim 1	1-19
	EP 1 173 447 A (GEN ELECTRIC) 23 January 2002 (2002-01-23) claim 1  DE 34 25 424 A (GEN ELECTRIC) 7 February 1985 (1985-02-07) claim 1

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Intermalial Application No
PCT/FR2004/002759

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
FR 2848211	A	11-06-2004	FR	2848211 A1	11-06-2004
20 .022		<b></b>	AU	2003298434 A1	10-08-2004
			WO	2004063205 A1	29-07-2004
EP 0778279	Α	11-06-1997	US	5596119 A	21-01-1997
			DE	69631944 D1	29-04-2004
			DE	69631944 T2	20-01-2005
			EP	0778279 A1	11-06-1997
~			JP 	9169778 A	30-06-1997
US 6258970	B1	10-07-2001	EP	1156051 A2	21-11-2001
			JP	2002179686 A	26-06-2002
			DE	60003667 D1	07-08-2003
			DE	60003667 T2	15-04-2004 23-01-2002
			EP JP	1173447 A1 2002542250 T	10-12-2002
			WO	0063217 A1	26-10-2000
EP 1156051	Α	21-11-2001	US	6258970 B1	10-07-2001
			EP	1156051 A2	21-11-2001
			JP 	2002179686 A	26-06-2002
EP 1173447	Α	23-01-2002	DE	60003667 D1	07-08-2003
			DE	60003667 T2	15-04-2004
			EP	1173447 A1	23-01-2002
			JP	2002542250 T	10-12-2002
			WO	0063217 A1	26-10-2000 10-07-2001
			US 	6258970 B1	10-07-2001
DE 3425424	Α	07-02-1985	US	4500724 A	19-02-1985
			DE	3425424 A1	07-02-1985
			AU	3083784 A	31-01-1985
			BR	8403806 A	09-07-1985 01-12-1987
			CA DD	1229842 A1 232278 A5	22-01-1986
			DE	3448237 C2	02-02-1995
			FR	2549838 A1	01-02-1985
			GB	2144137 A ,B	27-02-1985
			JP	1040035 B	24-08-1989
			JР	1628201 C	20-12-1991
			JP	60078992 A	04-05-1985
			JP	1164439 A	28-06-1989
			JP	1935556 C	26-05-1995
			JP	5029400 B	30-04-1993
			SÜ	1838316 A3	30-08-1993 20-11-1990
			US	RE33452 E	50-11-1 <del>2</del> 30

# BES! AVAILABLE COP

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dema Internationale No PCT/FR2004/002759

A. CLASSE	MENT DE L'O	BJET DE	LA	DEMANDS
CIB 7	CO7F7/	16		

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

## B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) C1B 7 C07F

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, WPI Data, BEILSTEIN Data

C. DOCUME	NTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no des revendications visées
P,A	FR 2 848 211 A (RHONE POULENC CHIMIE) 11 juin 2004 (2004-06-11) revendication 1	1-19
Α	EP 0 778 279 A (DOW CORNING) 11 juin 1997 (1997-06-11) revendication 1; tableau 1	1-19
A	US 6 258 970 B1 (BABLIN JOHN MATTHEW ET AL) 10 juillet 2001 (2001-07-10) revendication 1; figure 1	1-19
A	EP 1 156 051 A (GEN ELECTRIC) 21 novembre 2001 (2001-11-21) revendication 1	1-19
	-/	

Your la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
"A" document définissant l'état général de la technique, non considére comme particulièrement perfinent  "E" document anténeur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date  "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de pnorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)  "O" document se référant à une drivulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens  "P" document publié avant la date de dépôt international, mais	T' document ulténeur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cîte pour comprendre le principe ou la théone constituant la base de l'invention X' document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément Y' document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du mêtier &' document qui fait partie de la même famille de brevets
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
20 avril 2005	02/05/2005
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale	Fonctionnaire autorisé
Office Européen des Brevets, P.B 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo nl, Fax (+31-70) 340-3016	Baston, E

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

PCT/FR2004/002759

C(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS  Catégorie   Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents   no. des revendications vis    A   EP 1 173 447 A (GEN ELECTRIC)   23 janvier 2002 (2002-01-23)   revendication 1
23 janvier 2002 (2002-01-23) revendication 1  DE 34 25 424 A (GEN ELECTRIC) 7 février 1985 (1985-02-07) revendication 1
revendication 1

# BEST AVAILABLE COPY

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Dema Internationale No PCT/FR2004/002759

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
FR 2848211	A	11-06-2004	FR	2848211 A1	11-06-2004
			AU	2003298434 A1	10-08-2004
			WO	2004063205 A1	29-07-2004
EP 0778279	Α	11-06-1997	US	5596119 A	21-01-1997
			DE	69631944 D1	29-04-2004
			DE	69631944 T2	20-01-2005
			EP	0778279 A1	11-06-1997
			JP	9169778 A	30-06-1997
US 6258970	B1	10-07-2001	EP	1156051 A2	21-11-2001
			JP	2002179686 A	26-06-2002
			DΕ	60003667 D1	07-08-2003
			DE	60003667 T2	15-04-2004
			EP	1173447 A1	23-01-2002
			JP	2002542250 T	10-12-2002
			WO	0063217 A1	26-10-2000
EP 1156051	Α	21-11-2001	US	6258970 B1	10-07-2001
			EP	1156051 A2	21-11-2001
			JP	2002179686 A	26-06-2002
EP 1173447	Α	23-01-2002	DE	60003667 D1	07-08-2003
			DE	60003667 T2	15-04-2004
			EP	1173447 A1	23-01-2002 10-12-2002
			JP WO	2002542250 T 0063217 A1	26-10-2000
			US	6258970 B1	10-07-2001
DE 3425424	Α	07-02-1985	US	4500724 A	19-02-1985
	•••	0, 00 2500	DE	3425424 A1	07-02-1985
			AU	3083784 A	31-01-1985
			BR	8403806 A	09-07-1985
			CA	1229842 A1	01-12-1987
			DD	232278 A5	22-01-1986
			DE	3448237 C2	02-02-1995
			FR	2549838 A1	01-02-1985
			GB	2144137 A ,B	27-02-1985
			JP	1040035 B	24-08-1989
			JP	1628201 C	20-12-1991
			JP	60078992 A	04-05-1985
			JP	1164439 A	28-06-1989
			JP	1935556 C	26-05-1995
			JP	5029400 B	30-04-1993
			SU	1838316 A3	30-08-1993
			US	RE33452 E	20-11-1990